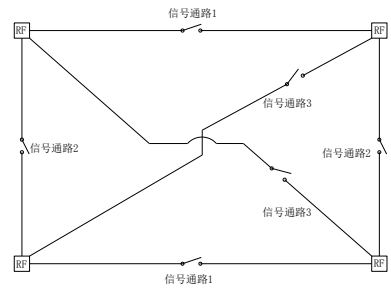


性能特点：

- 频率：2~18GHz
- 插损：3 dB
- 隔离度：50dB
- 输入输出回波损耗：15dB
- 芯片尺寸：2.5mm×2.0mm×0.1mm


产品简介：

HH-SW0218A1 是一款 GaAs MMIC 开关矩阵芯片，频率范围覆盖 2~18GHz，插入损耗小于 3.5dB，隔离度大于 45dB，HH-SW0218A1 采用 0/-5V 电压控制。

电参数： (TA=25°C)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	2~18			GHz
插入损耗	-	3.0	3.5	dB
隔离度	45	50	-	dB
输入回波损耗	14.5	15	-	dB
输出回波损耗	14.5	15	-	dB

使用限制参数：

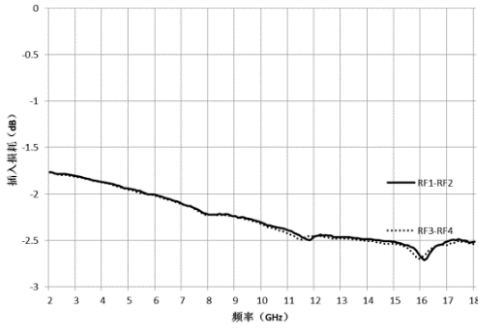
输入功率	+20dBm
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~125°C

真值表：

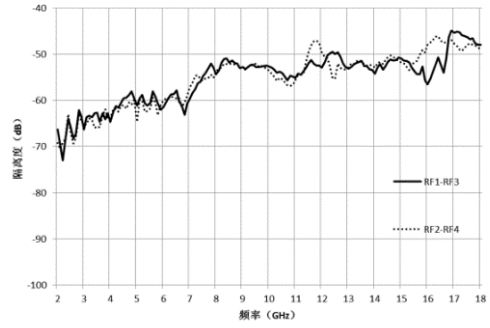
V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V1	V1	V1	V1	V1	V1	V1	双路 平行 控制	双路 交叉 控制	双路 垂直 控制
0	0	-5	-5	0	0	-5	-5	0	0	-5	-5	0	0	-5	-5	ON	OFF	OFF
-5	-5	0	0	0	-5	0	-5	-5	-5	0	0	0	-5	0	-5	OFF	ON	OFF
-5	0	-5	0	-5	0	-5	0	0	-5	-5	0	-5	0	-5	0	OFF	OFF	ON

典型曲线：

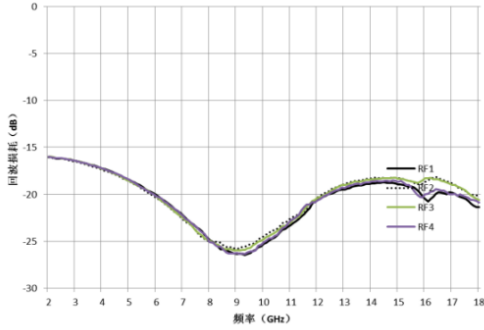
平行通路插入损耗 VS 频率



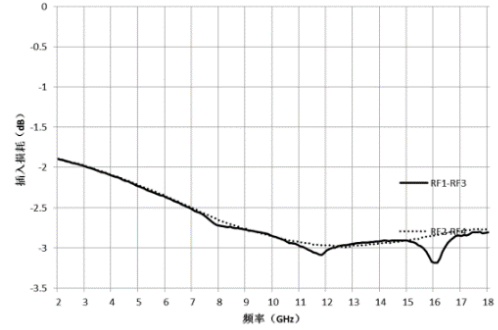
平行通路隔离度 VS 频率



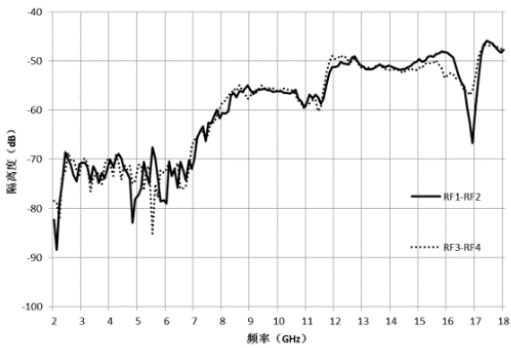
平行通路回波损耗 VS 频率



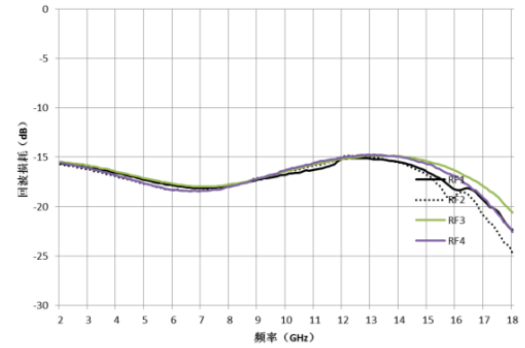
交叉通路插入损耗 VS 频率



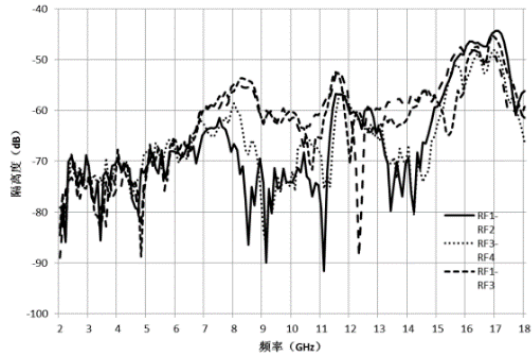
交叉通路隔离度 VS 频率



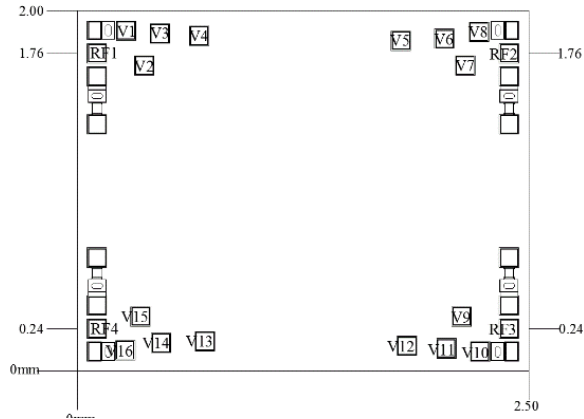
交叉通路回波损耗 VS 频率



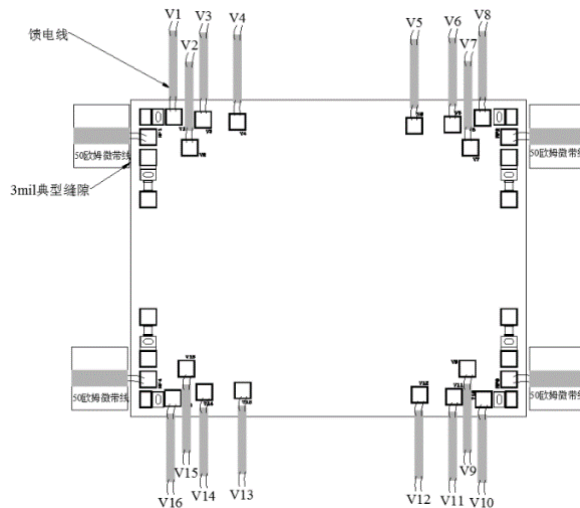
垂直通路隔离度 VS 频率



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

注意事项：输入输出无隔直电容，所有 C 电容值大小为 100PF。

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。